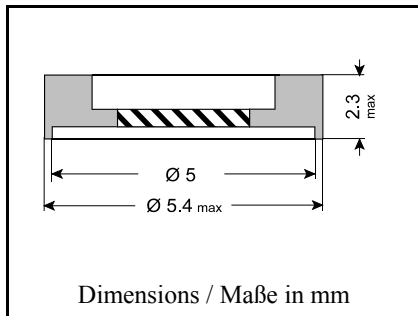


**Silicon Rectifier Cells  
with polysiloxan passivation**
**Silizium-Gleichrichterzellen  
mit Polysiloxan-Passivierung**


Nominal current – Nennstrom	3 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...1000 V
Weight approx. – Gewicht ca.	0.3 g
Standard packaging bulk Standard Lieferform lose	

**Maximum ratings and Characteristics**
**Kenn- und Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
AG 3A	50	80
AG 3B	100	130
AG 3D	200	250
AG 3G	400	450
AG 3J	600	700
AG 3K	800	1000
AG 3M	1000	1300

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwertschaltung mit R-Last	$T_T = 100^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	3 A <sup>1)</sup>
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	$I_{FRM}$	30 A <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	150 A
Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$i^2t$	110 A <sup>2</sup> s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_j$ $T_s$	– 50...+150°C – 50...+150°C
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 3\text{ A}$	$V_F < 1.2\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	$I_R < 10\ \mu\text{A}$

<sup>1)</sup> Max. temperature of the terminals  $T_T = 100^\circ\text{C}$  – Max. Temperatur der Kontaktflächen  $T_T = 100^\circ\text{C}$